

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
PUBLIC RELATIONS DIVISION
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310 Japon

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

n° 3132

Ce texte est une traduction de la version anglaise officielle de ce communiqué de presse. Il est fourni à titre de référence et pour votre confort uniquement. Pour tout détail ou spécificité, veuillez vous reporter à la version anglaise d'origine. La version anglaise d'origine prime, en cas de divergence.

Demandes de renseignements des clients

Contacts presse

Semiconductor & Device Marketing Div.B
Mitsubishi Electric Corporation

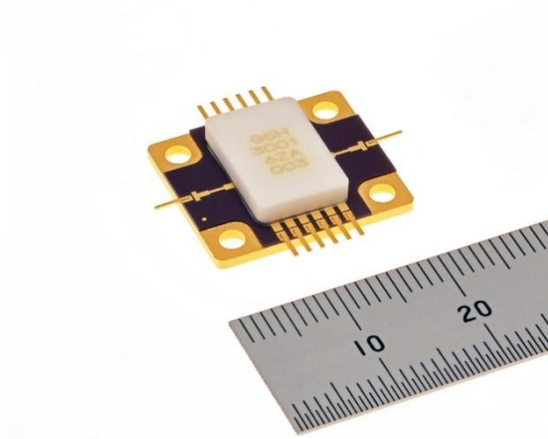
www.MitsubishiElectric.com/semiconductors

Public Relations Division
Mitsubishi Electric Corporation
prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp
www.MitsubishiElectric.com/news

Mitsubishi Electric s'apprête à lancer un MMIC HEMT GaN à bande Ka destiné aux stations terrestres de télécommunication par satellite

*La puissance de sortie élevée du dispositif et la faible distorsion obtenue contribueront à réduire la
taille des stations terrestres de télécommunication par satellite*

TOKYO, 4 octobre 2017 - Mitsubishi [Electric Corporation](http://www.mitsubishi-electric.com) (TOKYO : 6503) a annoncé aujourd'hui le lancement d'un amplificateur à circuit intégré monolithique hyperfréquence (MMIC) pour transistor à haute mobilité d'électrons (HEMT) au nitrure de gallium (GaN) à bande Ka (26-40 GHz) 8 W destiné aux stations terrestres de télécommunication par satellite. Le nouveau MGFG5H3001 offre à la fois une faible distorsion et une plage de puissance de sortie de 8 W inégalées sur le marché. Par ailleurs, son faible encombrement contribuera à la miniaturisation des émetteurs. Mitsubishi Electric enverra des échantillons à compter du 1er novembre.



MMIC HEMT GaN à bande Ka (MGFG5H3001)

Actuellement, les réseaux satellites utilisés pour la communication à haute vitesse lors de catastrophes naturelles et dans les régions où la construction de réseaux terrestres s'avère difficile opèrent principalement en bande C (4-8 GHz) et en bande Ku (12-18 GHz). Cependant, on constate une tendance marquée au fonctionnement sur des gammes de fréquences plus élevées. En outre, les déploiements en bande Ka, supérieure aux bandes C et Ku, font l'objet d'une demande accrue sur le marché. Le nouveau MMIC HEMT GaN à bande Ka de Mitsubishi Electric contribuera à répondre à la demande croissante relative aux déploiements en fréquences plus élevées. Il facilitera également le développement d'équipements de communication par satellite associant une puissance de sortie et une efficacité supérieures.

Caractéristiques du produit

1) Une puissance de sortie inégalée contribuant à la miniaturisation

- Une configuration de transistor optimisée capable de délivrer une puissance de sortie inégalée s'élevant à 8 W
- Une puce contenant les circuits des transistors de l'amplificateur permet d'associer ces circuits au linéarisateur, qui réduit la distorsion
- Le nombre limité de pièces contribuera à la miniaturisation des émetteurs utilisés dans les stations terrestres de télécommunication par satellite

2) Une réduction incomparable de la distorsion pour préserver efficacement le signal et faciliter la miniaturisation

- Un linéarisateur intégré qui permet de garantir une faible distorsion sur les émetteurs
- Une intégrité du signal élevée et un recours moindre à des linéarisateurs externes qui favorisent la miniaturisation accrue des émetteurs utilisés dans les stations terrestres de télécommunication par satellite

3) Les nouveaux équipements destinés aux stations terrestres de télécommunication par satellite répondront à des besoins plus variés

- Ce nouveau dispositif devrait permettre le déploiement de nouveaux équipements à bande Ka et des équipements à bande Ku actuels sur des gammes de fréquences plus diversifiées

Planning des ventes

Produit	Application	Modèle	Résumé			Livraison
			Fréquence	Puissance de sortie saturée	Gain linéaire	
MMIC HEMT GaN à bande Ka	Stations terrestres de télécommunication par satellite	MGFG5H3001	27,5-31,0 GHz	39,0 dBm (8 W)	15,0 dB	1er nov. 2017

Spécifications principales

	Symbole	MGFG5H3001
Tension drain-source	VDS	24 V
Fréquence	27,5-31,0 GHz (bande Ka)	
Puissance de sortie saturée	Psortie (type)	8 W
Gain linéaire	Plg (type)	15,0 dB

Gamme améliorée de HEMT GaN (nouveau modèle en caractères gras)

Fréquence	Modèle	Puissance de sortie saturée [W]	Gain linéaire [dB]
Bande Ka	MGFG5H3001	8	15,0
Bande Ku	MGFG5H1503	20	20,0
	MGFK47G3745A	50	8,0
	MGFK48G3745	70	10,0
	MGFK49G3745	80	7,5
	MGFK50G3745	100	10,0

Sensibilisation à l'environnement

Ce modèle respecte la directive européenne 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS).

Remarque : le développement de ces modèles a été partiellement pris en charge par l'agence japonaise New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO, Organisation pour le développement des énergies nouvelles et des technologies industrielles).

###

À propos de Mitsubishi Electric Corporation

Depuis plus de 90 ans, Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO : 6503) propose des produits fiables et de haute qualité. Ce leader international est reconnu pour la fabrication, le commerce et la vente d'équipements électriques et électroniques utilisés dans les domaines suivants : communications et traitement de l'information, développement spatial et communications par satellite, appareils électroniques grand public, technologie industrielle, énergie, transports et équipement de construction. En se conformant à l'esprit de sa devise « Changes for the Better » et de son engagement environnemental « Eco Changes », Mitsubishi Electric s'efforce d'être une entreprise pionnière et propre en plaçant la technologie au service de la société. L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires consolidé du Groupe de 4 238,6 milliards de yens (37,8 milliards de dollars US*) au cours du dernier exercice qui a pris fin le 31 mars 2017. Pour plus d'informations, veuillez consulter :

<http://www.MitsubishiElectric.com>

*À un taux de change de 112 yens pour 1 dollar US, taux indiqué par le Tokyo Foreign Exchange Market le vendredi 31 mars 2017